

Gegenüberstellung der neuen und alten Silizium-Solarstrahlungssensoren



Hinweise zu analogen Si-Sensoren

Übersicht	Si-Sensoren ab Oktober 2017	Si-Sensoren bis Oktober 2017
Messbereich Bestrahlungsstärke	0...1.500 W/m ²	Unterschiedlich je nach Typ
Messunsicherheit ^A	5 W/m ² ± 2,5% v. MW	5 W/m ² ± 2,5% v. MW
Messbereich Temperatur	-40...+90°C	Unterschiedlich
Messunsicherheit	Bis zu 1,3 K ^B	Bis zu 2,5 K

^A Gilt nicht für Si-mV-85 bzw. Si-02 und für Si-mV-85(-Pt100 / -Pt1000) bzw. Si-02(-Pt100 / -Pt1000) ohne externe Temperaturkompensation.

^B Detaillierte Informationen im technischen Datenblatt.

Ausgangssignal	Si-Sensoren ab Oktober 2017	Si-Sensoren bis Oktober 2017
100 mV Typ Bestrahlungsstärke Temperatur	Si-mV-85(-Pt100 / -Pt1000) 0...ca. 85 mV für 0...1.500 W/m ² Pt100 oder Pt1000	Si-02(-Pt100 / -Pt1000) 0...ca. 80 mV für 0...1.400 W/m ² Pt100 oder Pt1000
2 V Typ Bestrahlungsstärke Temperatur	Si-V-1.5TC(-T) 0...1,5 V für 0...1.500 W/m ² 0...2 V für -40...+90°C	Si-01TC(-T) 0...1,4 V für 0...1.400 W/m ² 0...2 V für -123,5...+76,5°C
10 V Typ Bestrahlungsstärke Temperatur	Si-V-10TC(-T) 0...10 V für 0...1.500 W/m ² 0...10 V für -40...+90°C	Si-13TC(-T) 0...10 V für 0...1.300 W/m ² 0...10 V für -26,1...+89°C
20 mA Typ Bestrahlungsstärke Temperatur	Si-I-420TC(-T) 4...20 mA für 0...1.500 W/m ² 4...20 mA für -40...+90°C	Si-420TC(-T) 4...20 mA für 0...1.200 W/m ² 4...20 mA für -123,5...+76,5°C

Hinweise zu digitalen Si-Sensoren

Übersicht	Si-Sensoren ab Oktober 2017	Si-Sensoren bis Oktober 2017
Messbereich Bestrahlungsstärke	0...1.500 W/m ²	0...1.400 W/m ²
Messunsicherheit	5 W/m ² ± 2,5% v. MW	5 W/m ² ± 2,5% v. MW
Messbereich Temperatur	-40...+90°C	-40...+90°C
Messunsicherheit	1 K (-35...+80°C)	1 K (-35...+80°C)